

圖 13-35 常見的接觸窗到多晶矽及場多晶矽到主動區的橋接漏電量測。

金屬通孔到通孔的漏電（Metal Via to Via Leakage）也是另一種不同層間的橋接行為，為了減少電路的使用面積，金屬線和通孔之間，經常沒有多餘的重疊，因而使通孔到通孔之間與上下金屬線的製程缺陷而產生橋接漏電的情形。

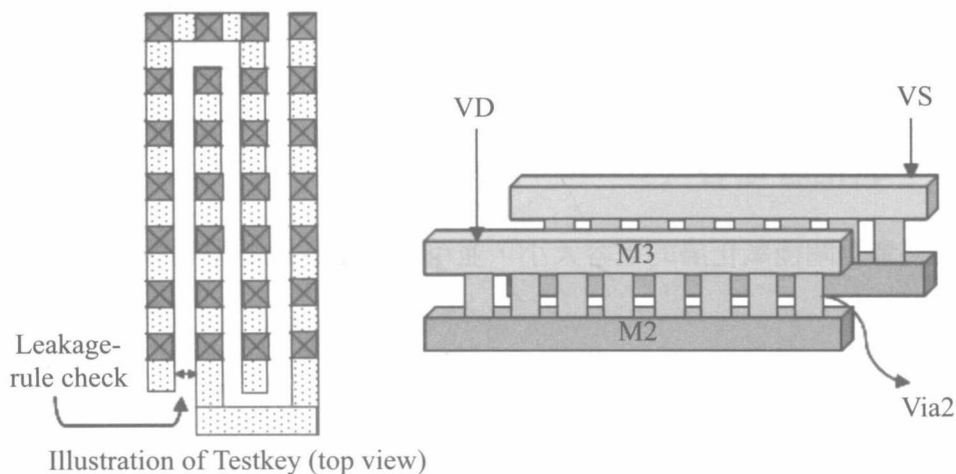


圖 13-36 常見的通孔到通孔間的橋接漏電測試鍵。